

Logical Effort

27 de octubre de 2024

1. El método de Logical Effort

El método de Logical Effort, creado por Ivan Sutherland y Bob Sproull en 1991, es una técnica de estimación de retardos en circuitos CMOS. Utilizada correctamente, ayuda en la selección de compuertas a utilizar para realizar una función lógica y dimensionar los transistores necesarios para alcanzar el mínimo retardo posible en el circuito.

Nada impediría realizar simulaciones con motores tipo SPICE para cada camino R2R que presente el diseño, analizando cada transistor y cada parásito pero probablemente llevaría excesivo tiempo de simulación y cada iteración sería muy costosa. Durante décadas el software CAD evolucionó para evitar este tipo de simulaciones, utilizando métodos que permitan tiempos de diseño razonables.

Nota: se recomienda mirar la entrada de Wikipedia de Ivan Sutherland, donde ni siquiera se hace mención a este método por tener tantas cosas para nombrar.

1.1. Retardo de una compuerta lógica

Ya tenemos una noción de los elementos que determinan el retardo de una compuerta, ahora vamos a simplificar para obtener un modelo mas simple.

Comenzamos con la referencia absoluta, un inversor:

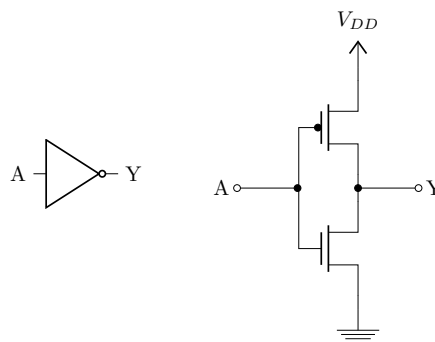


Figura 1: Inversor, símbolo y circuito.

En un modelo de primer orden, podemos considerar al inversor (2a) como una capacidad de entrada, un par de resistores y llaves, una capacidad de salida y una capacidad de carga a llenar. Si simplificamos aún mas el modelo, podemos considerar al inversor (2b) como una fuente y una resistencia de salida. Y finalmente, cada vez que aumentemos el tamaño de los transistores k veces tendremos k veces menos resistencia pero k veces mas capacidad (2c).

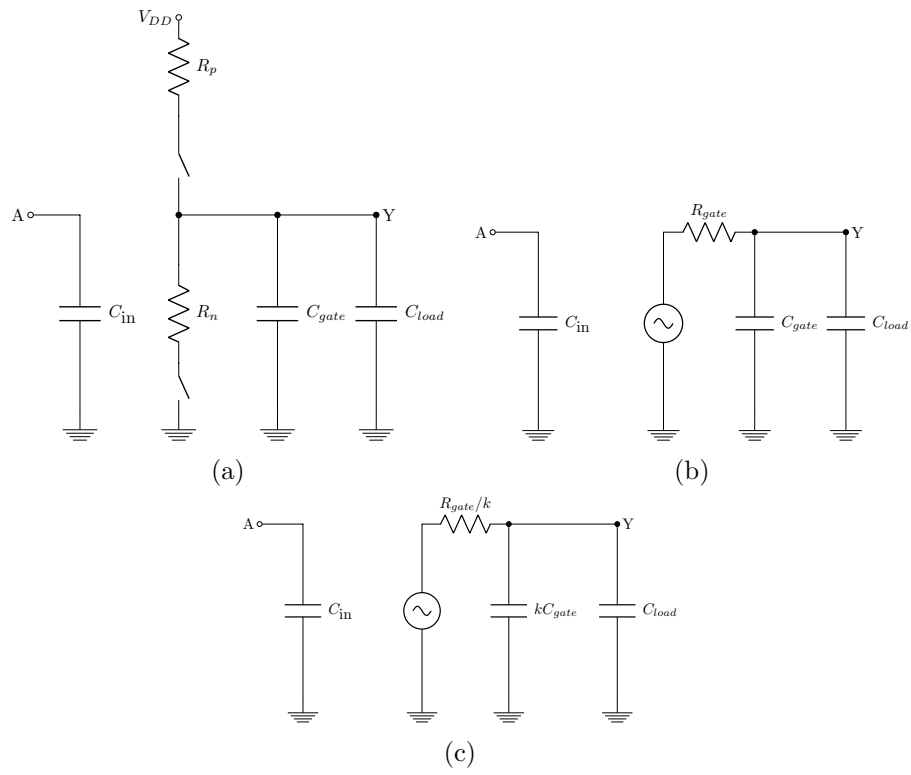


Figura 2: Inversor, modelo de primer orden

Realizando un análisis sobre la salida, definimos **Delay Absoluto** (d_{abs}) como:

$$d_{abs} = R_{gate}(C_{load} + C_{gate}) = \underbrace{R_{gate}C_{load}}_{\text{depende de la carga}} + \underbrace{R_{gate}C_{gate}}_{\text{constante}}$$

Considerando que la capacidad de la compuerta y su resistencia parásita son elementos indeseados, definimos **Parasitic Delay** (d_p) como:

$$d_p = R_{gate}C_{gate} \Rightarrow d_{abs} = R_{gate}C_{load} + d_p$$

Si analizamos la variación del delay absoluto en relación a la carga, obtenemos la curva 3a.

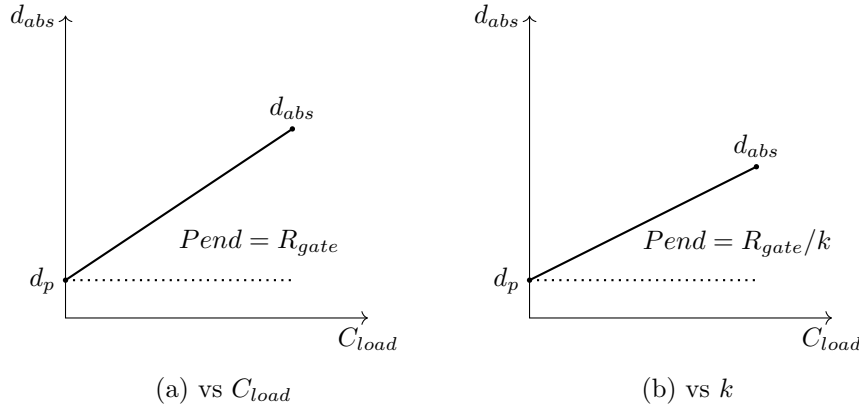


Figura 3: Parasitic Delay

Si se aumenta k veces el tamaño de la compuerta podemos suponer que tenemos el circuito representado en la Figura 2c.

Repetimos el análisis para un inversor k veces mas ancho:

$$d_{abs} = \frac{R_{gate}}{k}(kC_{gate} + C_{load}) = \frac{R_{gate}}{k}kC_{gate} + \frac{R_{gate}}{k}C_{load} = R_{gate}C_{gate} + \frac{R_{gate}}{k}C_{load}$$

$$d_{abs} = d_p + \frac{R_{gate}}{k}C_{load}$$

Podemos ver en la Figura 3b como tenemos un mismo valor mínimo de delay pero luego bajé el d_{abs} de mi inversor. Sin embargo, es a costa de aumentar la C_{load} de la etapa previa k veces. Esto empeora el delay de la etapa anterior, a costa de mejorar la actual. Tenemos que optimizar estas relaciones para el mejor delay total.

Definimos al **Esfuerzo Eléctrico** (h) como la relación entre la capacidad de entrada de mi carga y la capacidad de entrada de mi compuerta:

$$h = \frac{C_{load}}{C_{in}}$$

Supongamos que podemos escribir la capacidad de cualquier compuerta $C_{in_{gate}}$ como:

$$C_{in_{gate}} = \alpha \cdot C_{in_0}$$

donde C_{in_0} es la capacidad de entrada del inversor de tamaño mínimo. Entonces:

$$\alpha = \frac{C_{in_{gate}}}{C_{in_0}} \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = \frac{C_{in_0}}{C_{in}}$$

Lo mismo sucede con la capacidad de salida $C_{gate} = \alpha \cdot C_{gate_0}$. Esto indica que si los transistores de la compuerta aumentan α veces respecto a la misma compuerta de tamaño mínimo entonces su capacidad aumenta α veces y su resistencia disminuye α veces.

Luego:

$$R_{gate} = \frac{R_{gate_0}}{\alpha} = R_{gate_0} \frac{C_{in_0}}{C_{in}}$$

Sabemos que:

$$\begin{aligned} d_{abs} &= R_{gate} C_{load} + R_{gate} C_{gate} \\ &= \frac{R_{gate_0}}{\alpha} C_{load} + \frac{R_{gate_0}}{\alpha} \alpha C_{gate_0} \\ &= \frac{R_{gate_0}}{\alpha} C_{load} + R_{gate_0} C_{gate_0} \\ &= R_{gate_0} \frac{C_{in_0}}{C_{in}} C_{load} + R_{gate_0} C_{gate_0} \\ &= \underbrace{R_{gate_0} C_{in_0}}_g \underbrace{C_{load}/C_{in}}_h + \underbrace{R_{gate_0} C_{gate_0}}_p \end{aligned}$$

Que reescribimos como:

$$d_{abs} = g \cdot h + p$$

En dicha ecuación, tenemos los siguientes elementos:

- g : Logical effort
- h : Electrical effort
- p : Parasitic delay

Como podemos apreciar, el Logical Effort ($g = R_{gate_0} \cdot C_{in_0}$) depende exclusivamente del tipo de compuerta y de su topología de transistores, no de su tamaño.

Usualmente tambien se define el esfuerzo de la etapa, Stage Effort (f) como:

$$f = g \cdot h$$

Notar que:

$$h_0 = \frac{C_{load}}{C_{in}} = \text{cte} \Rightarrow d_{abs} = \text{cte}$$

Nuestro delay absoluto de la celda se mueve en un espacio definido por el tamaño de la misma y la carga que tiene:

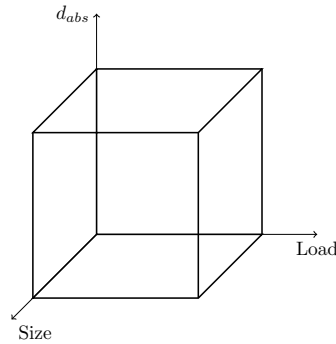


Figura 4

En general se usa una constante τ que depende del proceso y se expresa todo en unidades $d_{abs} = d'_{abs} \tau = \tau(gh + d_p)$.

2. Valores de Logical Effort y Parasitic delay

Las siguientes tablas poseen valores conocidos de g y p :

	Cantidad de entradas					
g	1	2	3	4	5	n
Inverter	1	-	-	-	-	-
NAND	-	4/3	5/3	6/3	7/3	$(n+2)/3$
NOR	-	5/3	7/3	9/3	11/3	$(2n+1)/3$
XOR	-	4	12	32	-	-

(a) Algunos valores de g

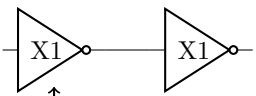
Gate	p
Inversor	p_{inv}
n -NAND	np_{inv}
n -NOR	np_{inv}
2-XOR	$4p_{inv}$

(b) Algunos valores de p

3. Ejemplos de cálculo de delay

3.1. Inversor mínimo cargado por inversor mínimo

Si utilizamos el método para calcular el delay absoluto de un inversor unitario cargado con otro inversor unitario, obtendremos:



$$d = gh + p$$

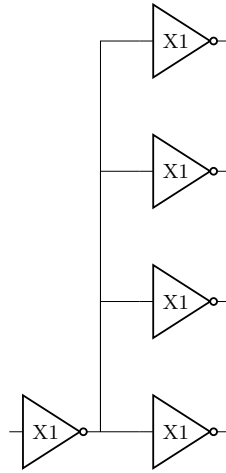
$$h = C_{out}/C_{in} = 1, \quad g = 1$$

$$p = p_{in} \text{ (suponemos } p_{in} = 1)$$

$$d = 1 \cdot 1 + 1 = 2$$

3.2. Inversor mínimos con múltiples cargas

En este caso, podemos ver como el delay aumenta como función del aumento de la capacidad de carga.



$$h = C_{out}/C_{in} = 4$$

$$g = 1$$

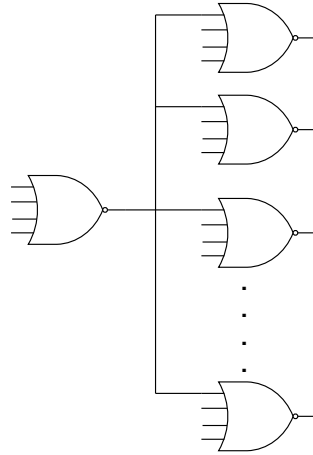
$$p_{inv} = 1$$

$$d = g \cdot h + p = 4 \cdot 1 + 1$$

$$d = 5$$

3.3. Compuerta NOR de 4 entradas

A continuación vemos un ejemplo de una NOR de 4 entradas cargando múltiples compuertas del mismo tipo.



$$h = C_{out}/C_{in} = 10$$

$$g = 9/3 = 3$$

$$p = N \cdot p_{inv} = N \cdot 1 = 4$$

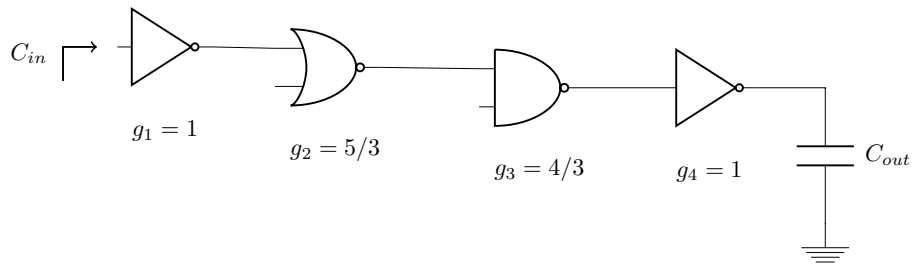
$$d = g \cdot h + p = 10 \cdot 3 + 4 = 34$$

4. Circuitos multinivel

4.1. Logical Effort en circuitos multinivel

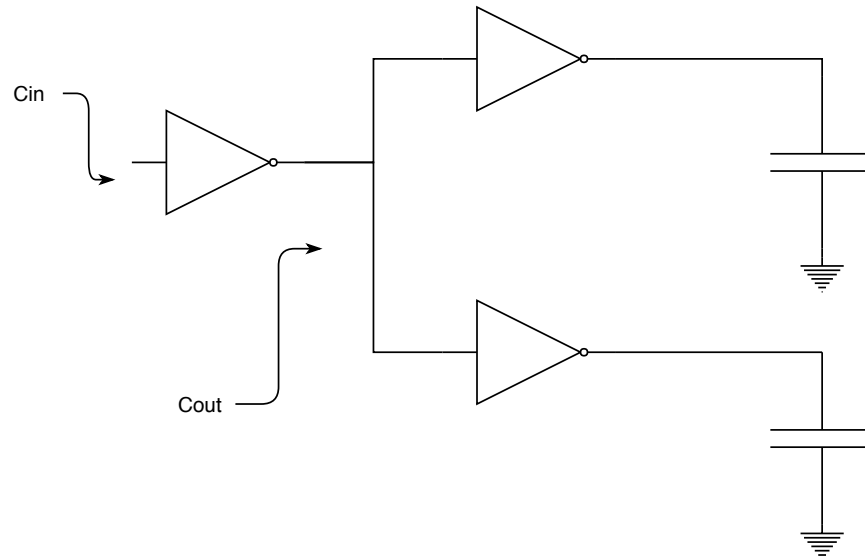
A lo largo de un path el logical effort (G en circuitos multinivel) y el electrical effort (H) es:

$$G = \prod g_i, H = \frac{C_{out}}{C_{in}}$$



$$G = 1 \cdot 5/3 \cdot 4/3 \cdot 1 = 20/9$$

En general $F \neq GH$, ya que existen circuitos con ramificaciones



4.2. Branching Effort

Como existen dichos casos, debemos definir un nuevo elemento, el **Branching Effort**

$$h = \frac{C_{in}}{C_{out}} = \frac{C_{on\ path} + C_{off\ path}}{C_{in\ path}} = \frac{C_{on\ path}}{C_{in\ path}} \cdot b$$

$$b = \frac{C_{on\ path} + C_{off\ path}}{C_{in\ path}} \leq 1$$

A lo largo de un path, el Branching Effort será:

$$B = \prod b_i$$

Ahora sí podemos definir el esfuerzo de un camino **Path Effort** con branches,

$$F = G \cdot B \cdot H$$

$$\begin{aligned} BH &= \prod b_i \left(\frac{C_{out}}{C_{in}} \right) \\ &= \prod b_i \left(\frac{C_{out}}{C_{in_N}} \times \frac{C_{in_N}}{C_{in_{N-1}}} \times \dots \times \frac{C_{in_2}}{C_{in_1}} \right) \\ &= \prod \left(b_i \frac{C_{in_{i+1}}}{C_{in_i}} \right) \\ &= \prod h_i \end{aligned}$$

Observación: El *Path Effort* depende sólo de la topología del circuito y la carga y no del tamaño de las compuertas utilizadas.

Más aún, si se agregan inversores o se quitan inversores del *path* F permanece constante ya que el esfuerzo lógico del inversor es 1.

4.3. Path Delay

En base a los elementos previos, podemos ahora analizar el delay total de un camino:

- Path Delay:

$$D = \sum d_i, \text{ donde } d_i = \text{es el delay de cada etapa a lo largo del path.}$$

- Path effort delay:

$$D_f = \sum g_i h_i$$

- Path parasitic delay

$$P = \sum p_i$$

Entonces **Path Delay** queda definido como:

$$D = \sum d_i = \sum (g_i h_i + p_i) = \sum g_i h_i = D_f + P$$

5. Path Delay mínimo

5.1. Teorema 1: Existe un Path Delay Mínimo

Teorema 1

El path delay es mínimo cuando cada etapa a lo largo del path tiene el mismo stage effort f_i . Es decir $f_i = f_j$ para todo $i, j \leq N$. Por lo tanto $f = \sqrt[N]{F}$. Demostramos el valor optimo de f por el simbolo \hat{f} . Es decir: $\hat{f} = \sqrt[N]{F}$.

Colorario:

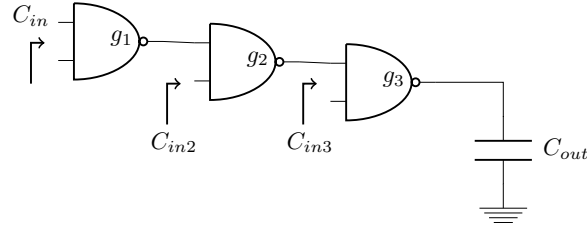
El valor mínimo del path delay es $\hat{D} = N\hat{f} + P$, donde $\hat{f} = \sqrt[N]{F}$. Para ecualizar f en cada etapa de forma que $f_i = \hat{f}$, para todo i , se debe elegir los tamaños de compuertas adecuados.

Sabemos que para una compuerta $f = g.h$, entonces $\hat{h}_i = \frac{\hat{f}_i}{g_i} = \frac{\sqrt[N]{F}}{g_i}$.

$$h_i = \frac{Cout_i}{Cin_i} \Rightarrow Cin_i \frac{Cout_i}{h_i} \Rightarrow \widehat{Cin_i} = \frac{Cout_i g_i}{\sqrt[N]{F}}$$

Es decir, si conocemos la capacidad de carga que nos presenta el circuito que recibe nuestro dato, podemos optimizar el tamaño de las compuertas para alcanzar el delay mínimo. Esta serie de ecuaciones nos dicen que hay un método algorítmico para ello. Para esto se empieza por la última etapa y se computan hacia atrás los valores óptimos de Cin_i , siendo este el dato para dimensionar las compuertas a utilizar.

5.2. Ejemplo: carga equivalente



Sea $C_{out} = C_{in}$:

- ¿ Cual es el mínimo delay posible ?
- ¿ Cual debe ser el tamaño de los transistores para lograr mínimo delay?

$$\left. \begin{aligned} G &= g_1 \cdot g_2 \cdot g_3 = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4^3}{3} \\ B &= b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \\ H &= C_{out}/C_{in} = 1 \end{aligned} \right\} F = GBH = \frac{4^3}{3}$$

Luego:

$$\hat{D} = N \cdot \sqrt[N]{F} + P = 3 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{4}{3}\right)^3} + 6 = 10$$

Donde:

$$P = \sum p_i = 3 \cdot (2 \cdot p_{inv}) = 6 \cdot p_{inv} = 6$$

$$p_{inv} = 1$$

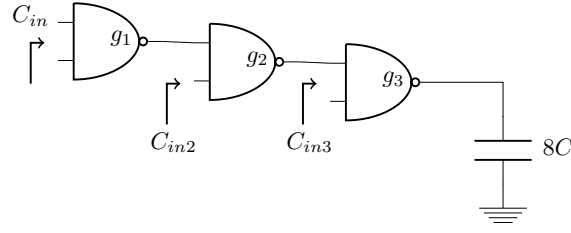
Por lo que el stage effort optimo seria:

$$\hat{f} = \sqrt[N]{F} = \sqrt[3]{\frac{4^3}{3}} = \frac{4}{3}$$

$$\left. \begin{aligned} C_{in3} &= \frac{C_{out} \cdot g_3}{4/3} = C_{out} \\ C_{in2} &= \frac{C_{in3} \cdot g_2}{4/3} = C_{out} \\ C_{in1} &= C_{out} \end{aligned} \right\} \text{Las tres compuertas deben ser iguales}$$

y su tamaño de forma tal que $C_{in} = C$.

5.3. Ejemplo: carga mayor



$$B = 1 \cdot 1 \cdot 1$$

$$G = \frac{4^3}{3}$$

$$H = \frac{8 \cdot C}{C} = 8$$

$$F = G \cdot B \cdot H = \frac{4^3}{3} \cdot (8)$$

$$\hat{D} = N \cdot \sqrt[N]{F} + P = 3 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdot 8} + 3 \cdot p_{inv} = 3 \cdot \frac{4}{3} \cdot 2 + 6 = 14$$

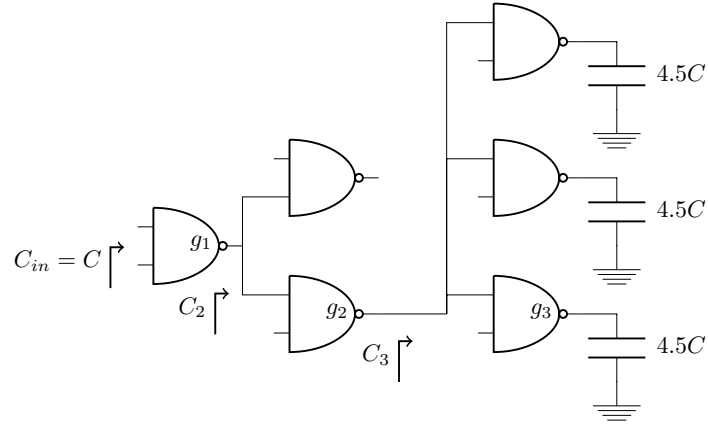
$$\hat{f} = \sqrt[N]{F} = \sqrt[3]{\frac{4^3}{3} \cdot 8} = \frac{8}{3}$$

Se observa que cada compuerta duplica el ancho de los transistores de la anterior (lo cual era de esperarse).

$$\begin{cases} Cin_3 = \frac{C_{out} \cdot g_3}{\hat{f}} = \frac{8 \cdot C \cdot (4/3)}{8/3} = 4 \cdot C \\ Cin_2 = \frac{C_{in_3} \cdot g_2}{\hat{f}} = \frac{4 \cdot C \cdot (4/3)}{8/3} = 2 \cdot C \\ Cin_1 = \frac{C_{in_2} \cdot g_1}{\hat{f}} = \frac{2 \cdot C \cdot (4/3)}{8/3} = C \end{cases}$$

Debe elegirse la primer componente de forma tal que la primera tenga una capacidad de entrada igual a C.

5.4. Ejemplo: branching multicarga



$$G = g_1 \cdot g_2 \cdot g_3$$

$$B = b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$$

$$H = \frac{4,5 \cdot C}{C} = 4,5 = \frac{9}{2}$$

$$F = G \cdot B \cdot H = \frac{4^3}{3} \cdot 6 \cdot \frac{9}{2} = 64$$

$$\hat{D} = N \cdot \sqrt[N]{F} + P = 3 \cdot \sqrt[3]{64} + 3 \cdot (2 \cdot p_{inv}) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 18$$

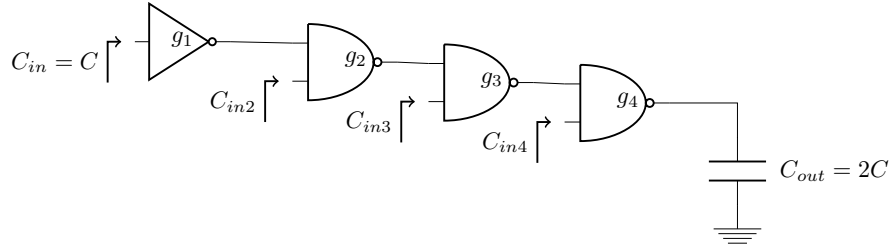
$$\hat{f} = \sqrt[3]{F} = 4$$

$$Cin_3 = \frac{C_{out} \cdot g_3}{\hat{f}} = \frac{4,5 \cdot C \cdot \frac{4}{3}}{4} = 1,5C$$

$$Cin_2 = 3 \cdot \frac{Cin_3 \cdot g_2}{\hat{f}} = \frac{3 \cdot 1,5 \cdot C \cdot \frac{4}{3}}{4} = 1,5C$$

$$Cin_1 = 2 \cdot \frac{Cin_2 \cdot g_1}{\hat{f}} = \frac{2 \cdot 1,5 \cdot C \cdot \frac{4}{3}}{4} = C$$

5.5. Ejemplo: múltiples tipos de compuertas



$$B = b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \cdot b_4 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$H = C_{out} = C_{in} = 2$$

$$G = g_1 \cdot g_2 \cdot g_3 \cdot g_4 = 1 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot 1 = \frac{20}{9}$$

$$F = G \cdot B \cdot H = \frac{40}{9}, \text{ donde } P = p_{inv} + 2 \cdot p_{inv} + 2 \cdot p_{inv} + p_{inv} = 6 \cdot p_{inv} = 6$$

$$\hat{D} = N \cdot \sqrt[N]{F} + P = 4 \cdot \sqrt[4]{\frac{40}{9}} + 6 = 4 \cdot 1,45 + 6 = 11,8$$

$$\hat{F} = \sqrt[4]{F} = \sqrt[4]{\frac{40}{9}} = 1,45$$

$$C_{in4} = \frac{C_{out} \cdot g_4}{\hat{f}} = \frac{2 \cdot C \cdot 1}{1,45} = 1,38C$$

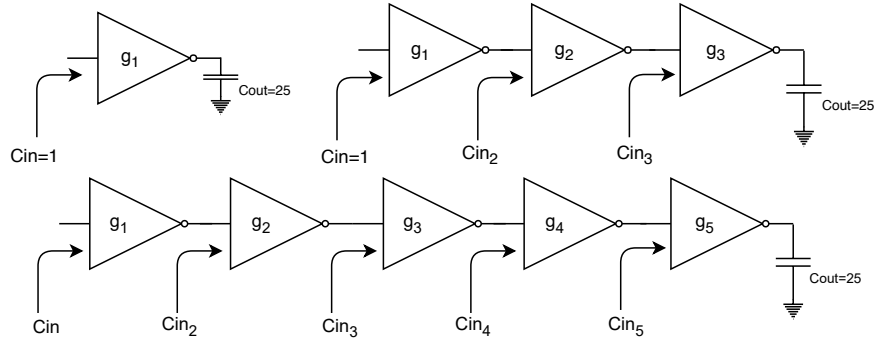
$$C_{in3} = \frac{C_{in4} \cdot g_3}{\hat{f}} = \frac{1,38 \cdot C \cdot \frac{4}{3}}{1,45} = 1,27C$$

$$C_{in2} = \frac{C_{in3} \cdot g_2}{\hat{f}} = \frac{1,27 \cdot C \cdot \frac{5}{3}}{1,45} = 1,45C$$

$$C_{in1} = \frac{C_{in2} \cdot g_1}{\hat{f}} = \frac{1,45 \cdot C \cdot 1}{1,45} = C$$

5.6. Ejemplo: múltiples inversores

En este caso, vamos a suponer que tenemos 3 alternativas de circuitos para elegir, todos con la misma carga y usando el mismo tipo de inversor:



$$H = 25$$

$$P = N \cdot p_{inv} = N$$

$$B = 1$$

$$G = \prod g_i = 1$$

$$F = G \cdot B \cdot H = 25$$

- 1 INV, entonces $\hat{D} = 1 \cdot \sqrt[25]{F} + P = 25 + 1 = 26$
- 3 INV, entonces $\hat{D} = 3 \cdot \sqrt[3]{25} + 3 = 11,17$
Este es la mejor elección.
- 5 INV entonces $\hat{D} = 5 \sqrt[5]{25} + 5 = 14,51$

5.7. Demostración del teorema 1

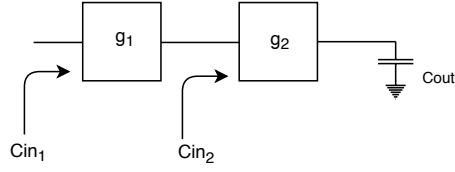


Figura 5: Esquema Calculo Delay path

$$D = \sum (g_1 \cdot k_i + p_i) = g_1 \frac{C_{in2}}{C_{in1}} + p_i + g_2 \frac{C_{out}}{C_{in2}} + p_2$$

$$b_1 = b_2 = 1$$

$$H = h_1 \cdot h_2 = \frac{C_{out}}{C_{in1}}$$

Entonces:

$$h_2 = \frac{H}{h_1}$$

Luego:

$$D = g_1 \cdot h_1 + p_1 + g_2 \cdot \frac{H}{h_1} + p_2$$

Para buscar el mínimo derivamos e igualamos a cero.

$$\frac{dD}{dh_1} = g_1 - g_2 \cdot h \cdot \frac{1}{h_1^2} = g_1 - g_2 \cdot \frac{h_2}{h_1} = 0$$

Entonces

$$g_1 \cdot h_1 = g_2 \cdot h_2$$

$$f_1 = f_2$$

.

Este resultado se puede extender a cualquier número arbitrario de etapas y branching efforts.

Sabemos que:

$$B \cdot H = h_1 \cdot h_2 \cdot \dots \cdot h_n$$

$$G = g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_n$$

$$(g_1 \cdot h_1) \cdot (g_2 \cdot h_2) \cdot \dots \cdot (g_n \cdot h_n) = G \cdot B \cdot H = F$$

Todos los factores, entre paréntesis, deben ser iguales para obtener mínimo delay, entonces:

$$\hat{f} = \sqrt[N]{F}$$

Veamos ahora cuántas etapas deben tener el path para obtener el mínimo delay.

Sea un path que contiene n_1 compuertas al que se le agregan n_2 inversores obteniéndose $N = n_1 + n_2$. Se asume que las n_1 compuertas originales sólo pueden cambiar de tamaño ya que generan la función lógica requerida mientras que la cantidad n_2 de inversores puede ser alterada para reducir el retardo del path. Aunque n_2 debe ser par para no alterar la función lógica, se asume que si n_2 es impar se puede cambiar la función lógica a su valor negado. Se supone conocido el path effort $F = G \cdot B \cdot H$, el lógico effort G y el branching effort B dependen de las n_1 compuertas originales y no pueden ser alterados agregando inversores. H es constante ya que depende de las cargas de entrada y salida que consideramos inalterables. El retardo mínimo de las N etapas es la suma del retardo de las n_1 compuertas originales y los n_2 inversores.

$$\hat{D} = N \cdot \sqrt[N]{F} + \sum_{i=1}^{N_1} f_i + (N - n_1) \cdot p_{inv}$$

donde $N - n_1 = n_2$.

$$\frac{d\hat{D}}{dN} = F^{1/N} - F^{1/N} \cdot \ln(F^{1/N}) + p_{inv}$$

Entonces: \hat{N} es el valor de N que hace que

$$\frac{d\hat{D}}{dN} = 0$$

Sea ahora $\rho = F^{1/\hat{N}}$ entonces $p_{inv} + \rho(1 - \ln \rho) = 0$

Cuando cada etapa tiene un esfuerzo lógico ρ , se alcanza el mínimo retardo. Se denomina ρ como *best stage effort*.

Observación 1:

- \hat{f} determina el f óptimo cuando N es conocido fijo.
- ρ determina el f óptimo que tiene cada etapa cuando el N es óptimo ($N = \hat{N}$).

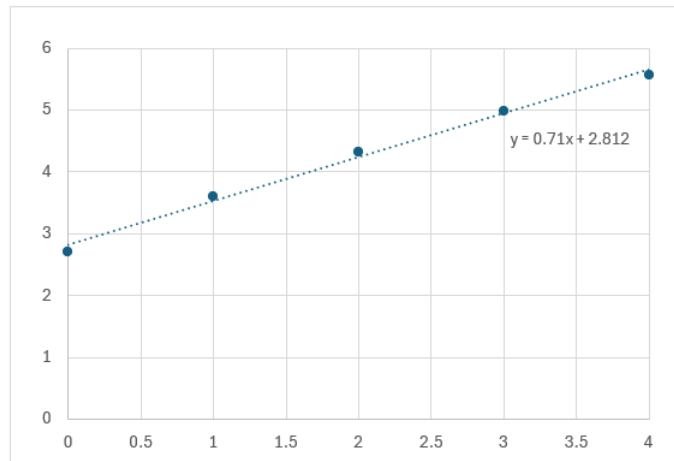
Observación 2:

Se puede tabular la solución de la ecuación $\rho = F^{1/\hat{N}}$ entonces $p_{inv} + \rho \cdot (1 - \ln \rho) = 0$ para los distintos valores de p_{inv} :

p_{inv}	ρ
0	2.71 (e)
1	3.59
2	4.32
3	4.97
4	5.57

Esta tabla suele aproximar por $\rho = 0,71 + 2,812 \cdot p_{inv}$, y para el caso particular de $p_{inv} = 1$ se tiene que $\rho = 3,59$.

p_{inv}	ρ
0	2.71
1	3.59
2	4.32
3	4.97
4	5.57



5.8. Procedimiento

1. Hallar ρ .
2. Conociendo F hallar $\hat{N} = \log_\rho(F) = \log_{10}(F)/\log_{10}(\rho)$.
3. Teniendo ρ y b_i hallar el tamaño de las compuertas (capacidades de entradas).
4. El delay mínimo será $\hat{D} = \hat{N}\rho + \sum p_i$.

6. N no óptimo

Sabiendo que existe un N óptimo, puede ser que utilizarlo no sea posible. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué sucede si no se usa el valor óptimo de \hat{N} .

Sabemos que

$$\hat{D} = \hat{N} \sqrt[\hat{N}]{\hat{N}F} + \sum p_i \quad (1)$$

Luego

$$D(N) = N \left(\sqrt[N]{F} + \frac{\sum p_i}{N} \right) \quad (2)$$

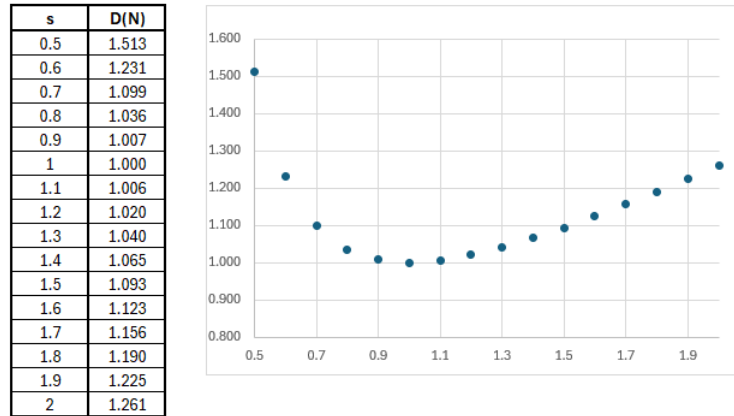
Sea $p = \sum p_i/N$ y sea $N = s\hat{N}$, entonces

$$r = \frac{D(N)}{D(\hat{N})} = \frac{D(s\hat{N})}{D(\hat{N})} = \frac{s(\rho^{1/s} + p)}{\rho + p} \quad (3)$$

Si $p = 1$ entonces $\rho = 3,59$, entonces por ejemplo:

- Si $s = 2$, $N = 2\hat{N}$ entonces $D(N) = 1,26D(\hat{N})$
- Si $s = 0,5$, $N = \hat{N}/2$ entonces $D(N) = 1,51D(\hat{N})$

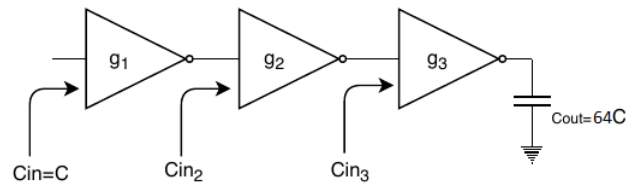
Se concluye entonces que equivocarse entre la mitad o el doble de la cantidad de etapas óptimas sube el retardo entre un +26 % y un +51 %.



7. Tamaño no óptimo

Muy probablemente no podamos utilizar cualquier tamaño de compuerta, debido a las limitaciones de los elementos disponibles en nuestro PDK. Por lo tanto debemos preguntarnos qué sucede si no se usa el tamaño óptimo para cada compuerta.

Considerar el siguiente ejemplo:



$$g_1 = g_2 = g_3 = 1, G = 1$$

$$b_1 = b_2 = b_3 = 1, B = 1$$

$$H = \frac{64C}{C} = 64$$

$$F = G \cdot B \cdot H = 64$$

$$\hat{f} = \sqrt[3]{F} = 4$$

Luego

$$\begin{aligned} C_{IN_3} &= \frac{C_{OUT} \cdot g_3}{\hat{f}} = \frac{64C \cdot 1}{4} = 16C \\ C_{IN_2} &= \frac{C_3 \cdot g_2}{\hat{f}} = \frac{16C \cdot 1}{4} = 4C \\ C_{IN_1} &= \frac{C_2 \cdot g_1}{\hat{f}} = \frac{4C \cdot 1}{4} = C \end{aligned}$$

Supongamos ahora que $C_{IN_2} = s \cdot 4C$ entonces:

$$h_1 = \frac{C_{IN_2}}{C_{IN_1}} = \frac{s \cdot 4C}{C} = 4s$$

$$h_2 = \frac{C_{IN_3}}{C_{IN_2}} = \frac{16C}{s \cdot 4C} = \frac{4}{s}$$

$$h_3 = \frac{C_{OUT}}{C_{IN_3}} = \frac{64C}{16C} = 4$$

Luego,

$$f_1 = g_1 \cdot h_1 = 1 \cdot 4s = 4s$$

$$f_2 = g_2 \cdot h_2 = 1 \cdot 4/s = 4/s$$

$$f_3 = g_3 \cdot h_3 = 1 \cdot 4 = 4$$

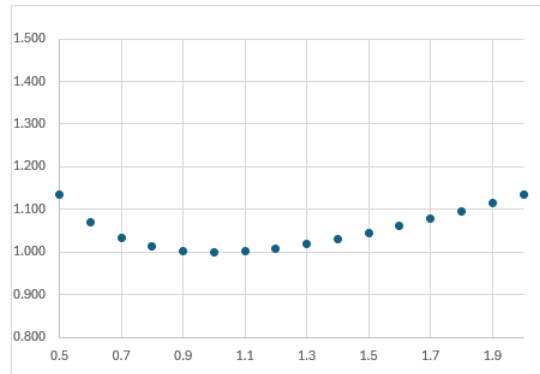
$$F = f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 = 4s \cdot \frac{4}{s} \cdot 4 = 64$$

$$D = \sum f_i + \sum p_i = \left(4s + \frac{4}{s} + 4\right) + (1 + 1 + 1) = 4(s + s^{-1}) + 7$$

$$\frac{D(s)}{D(1)} = \frac{4}{15}(s + s^{-1}) + 0,467$$

$$\frac{dD}{ds} = 4 \left(1 - \frac{1}{s^2}\right) = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad s = 1$$

s	D(s)/D(1)
0.3	1.436
0.4	1.240
0.5	1.133
0.6	1.071
0.7	1.034
0.8	1.013
0.9	1.003
1.0	1.000
1.1	1.002
1.2	1.009
1.3	1.018
1.4	1.030
1.5	1.044
1.6	1.060
1.7	1.077
1.8	1.095
1.9	1.114
2.0	1.133



Observación: Si se modifica el tamaño de la compuerta entre 0.5 y 2 veces respecto del valor óptimo, se tiene un aumento del retardo de un 13 %.

8. Definiciones equivalentes de Logical effort

- El logical effort de una compuerta se define como la cantidad de veces que la resistencia de salida de una compuerta es mayor a la de un inversor de idéntica capacidad de entrada.
- El logical effort de una compuerta se define como la relación entre su capacidad de entrada y la de un inversor con misma resistencia de salida.
- El logical effort de una compuerta se define como la pendiente de su retardo en función de la carga (C_L) dividida por la pendiente de la curva de retardo en función de la carga (C_L) de un inversor de la misma capacidad de entrada.

9. Multiple inputs gates

- Esfuerzo lógico por entrada: Efectividad de una entrada en controlar la corriente de salida respecto a un inversor de misma a_n .
- Esfuerzo lógico de un grupo de entradas: Efectividad de un grupo de entradas en controlar la corriente de salida respecto a un inversor de misma f_{in} .
- Esfuerzo lógico total: Efectividad de la totalidad de las entradas en controlar la corriente de salida respecto de un inversor de misma c_{in}

Sea b un grupo de entrada de una compuerta específica entonces:

$$g_b = \frac{C_b}{C_{inv}} = \frac{\sum_b C_i}{C_{inv}}$$

Donde c_{inv} es la capacidad de entrada de un inversor que entrega la misma cantidad de corriente.

Luego: $g_b = \sum_b g_i$, suma de los esfuerzos lógicos de cada entrada.

Supongamos que en un compuerta CMOS todos los transistores tienen el mismo L y todos los NMOS tiene un width W_N y los PMOS W_P .

En base a eso, podemos decir que la capacidad de entrada de un transistor NMOS es:

$$C_{in} = k \cdot W_N$$

Y la capacidad de entrada para un PMOS es:

$$C_{in} = k \cdot W_P$$

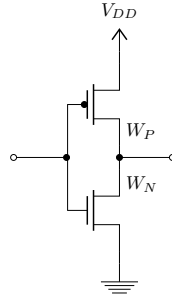


Figura 6: Esquema inversor CMOS

Supongamos $W_P = \alpha \cdot W_N$, entonces:

$$\begin{aligned} C_{in} &= k \cdot W_P + k \cdot W_N = k \cdot (W_P + W_N) \\ &= k \cdot W_N \cdot \frac{W_P}{W_N} + \frac{W_N}{W_N} = k \cdot W_N \cdot \left(\frac{W_P}{W_N} + 1 \right) \end{aligned}$$

Sea: $k \cdot W_N = W$, entonces $C_{in} = W(\alpha + 1)$.

Supongamos $\alpha = 2$, entonces $C_{in} = 3W$. Esto quiere decir que si la relación entre los anchos P y N (α) es de 2, la capacidad de entrada que presentará nuestro inversor será proporcional a 3 veces el ancho del transistor N.

9.1. Ejemplo NAND

L igual para todos los T_r

AB	A.B	\overline{AB}
00	0	1
01	0	1
10	0	1
11	1	0

Cuadro 2: Tabla de verdad ejemplo NAND

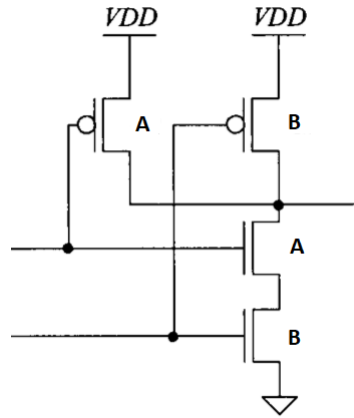


Figura 7: CMOS NAND

Analicemos R_{onN} y R_{onP} para cierto $\alpha = \frac{W_P}{W_N}$, (L igual para todos los T_r 's).

Quiero que la resistencia que presenta la rama N (suma de la resistencia de los N, al estar en serie), sea igual a la resistencia que presenta cada rama P al estar encendida:

$$R_{NON} = R_{onNA} + R_{onNB}$$

$$R_{PON} = R_{onPA} = R_{onPB}$$

Donde:

$$R_{onNA} + R_{onNB} = 2 \cdot R_{onNA} = 2 \cdot R_{onNB}$$

Para lograr que la R_{NON} de mi red sea equivalente a la de un inversor, la resistencia de cada uno debe ser la mitad. Para lograr esto, deben ser dos veces mas anchos que el

del inversor. Por lo tanto, cada transistor de la red N presenta 2 veces la capacidad de entrada de un transistor N de un inversor.

Para lograr que la R_{PON} de cada entrada sea equivalente a la de un inversor, la resistencia debe ser la misma en cada rama. Para lograr esto, deben ser del mismo tamaño que en el inversor. Asumiremos el caso típico donde la relación de tamaño entre P y N es de 2.

Por lo tanto, la capacidad de entrada será:

$$Cin_A = Cin_{AN} + Cin_{AP} = 2 + 2 = 4$$

$$Cin_B = Cin_{BN} + Cin_{BP} = 2 + 2 = 4$$

Lo que nos permite calcular el esfuerzo lógico de la compuerta:

$$g_i = \frac{Cin_i}{C_{inv}} = \frac{4}{3}$$

Este es el valor que encontraremos en la Tabla 1a.

También podemos calcular el esfuerzo lógico total:

$$g = g_A + g_B = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

9.2. Ejemplo NOR

L igual para todos los T_r

AB	OR	NOR
00	0	1
01	1	0
10	1	0
11	1	0

Cuadro 3: Tabla de verdad ejemplo NOR

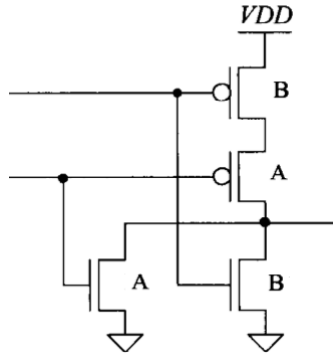


Figura 8: CMOS NOR

Analicemos R_{onN} y R_{onP} para cierto $\alpha = \frac{W_P}{W_N}$, (L igual para todos los $T_{r's}$).

Quiero que la resistencia que presenta la rama P (suma de la resistencia de los P, al estar en serie), sea igual a la resistencia que presenta cada rama N al estar encendida:

$$R_{NON} = R_{onNA} = R_{onNB}$$

$$R_{PON} = R_{onPA} + R_{onPB}$$

Donde:

$$R_{onPA} + R_{onPB} = 2 \cdot R_{onPA} = 2 \cdot R_{onPB}$$

Para lograr que la R_{NON} de mi red sea equivalente a la de un inversor, la resistencia debe ser la misma en cada rama. Para lograr esto, deben ser del mismo tamaño que en el inversor. Por lo tanto, cada transistor de la red N presenta la capacidad de entrada de un transistor N de un inversor.

Para lograr que la R_{PON} de cada entrada sea equivalente a la de un inversor, la resistencia de cada uno debe ser la mitad. Asumiremos el caso típico donde la relación de tamaño entre P y N es de 2. Por lo tanto, nuestros transistores P tienen que ser 4 veces mas grandes que los N. Y presentarán 4 veces la capacidad de entrada.

Por lo tanto, la capacidad de entrada será:

$$Cin_A = Cin_{AN} + Cin_{AP} = 1 + 4 = 5$$

$$Cin_B = Cin_{BN} + Cin_{BP} = 1 + 4 = 5$$

Lo que nos permite calcular el esfuerzo lógico de la compuerta:

$$g_i = \frac{Cin_i}{C_{inv}} = \frac{5}{3}$$

Este es el valor que encontraremos en la Tabla 1a.

También podemos calcular el esfuerzo lógico total:

$$g = g_A + g_B = \frac{10}{3}$$

9.3. Spice simulation para determinar el logical effort

Sabemos que el logical effort de un inversor 1. Luego $d_{abs} = (g.h + p_{inv})\tau$ como $g = 1$, entonces $d_{abs} = \tau(h + p_{inv})$. Se levanta la siguiente curva por medio de simulación.

$$d_{abs} = (h + p_{inv})\tau$$

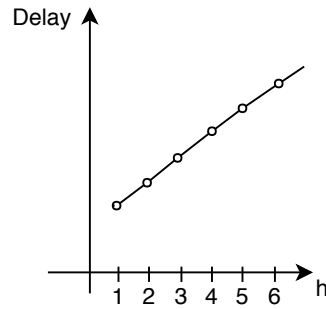


Figura 9: Curva de Delay

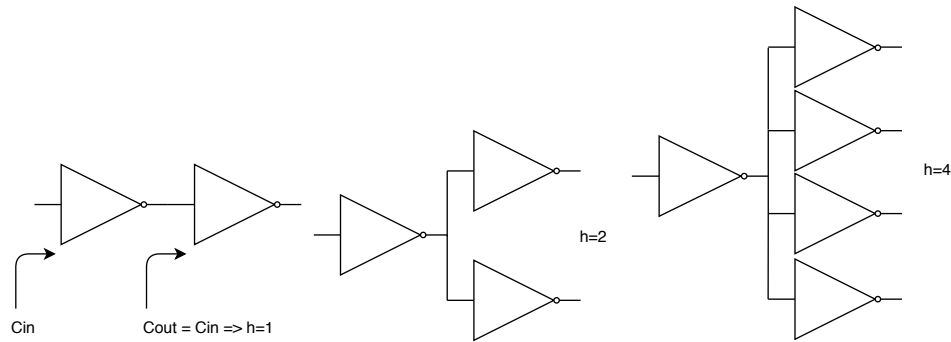


Figura 10: Modelos simulados

- Si $h = 0$, entonces $d_{abs} = p_{inv}\tau$. $p_{inv} = 1$, entonces obtengo el τ del proceso.
- Luego con este valor de τ se caracterizan las demás compuertas por medio de un procedimiento similar.

Observación

Pueden utilizarse compuertas asimétricas donde el logical effort sea distinto para cada entrada. Esto da flexibilidad para la optimización de ciertos paths.

Por ejemplo: Si en el siguiente circuito quisieramos optimizar el path 2 sin alterar el path 1 podemos utilizar una NAND asimétrica.

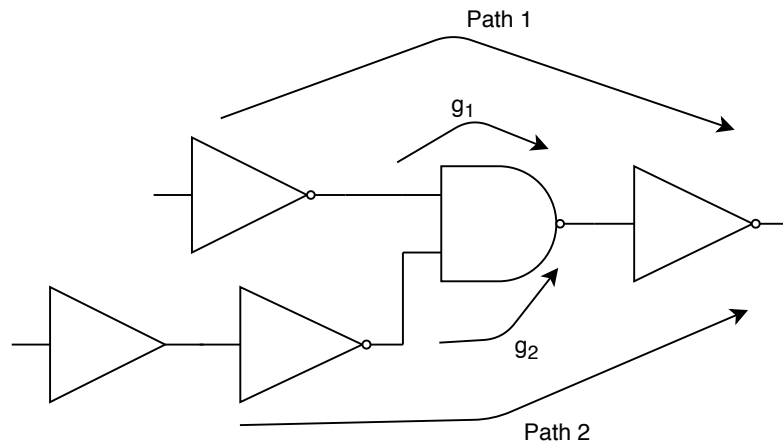


Figura 11: NAND Asimétrica.

10. Preguntas para pensar

1. Qué sucede si para un determinado período de operación requerido de clock, no se cumple en un path R2R con la restricción de setup time? Como puede hacer que el dicho path propague más rápido?
2. Discutir la necesidad de compuertas de misma función lógica pero distinto tamaño.
3. Discutir la necesidad de compuertas multi entrada asimétricas de forma de optimizar un path pero no alterar el otro.
4. Discutir como influyen los parásitos R-C en las interconexiones.